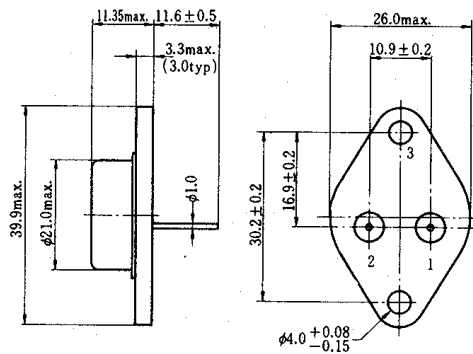


2SC3342

シリコン NPN 三重拡散形
TV 水平偏向出力用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
TV HORIZONTAL DEFLECTION OUTPUT



1. ベース : Base
 2. エミッタ : Emitter
 3. コレクタ : Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-3)

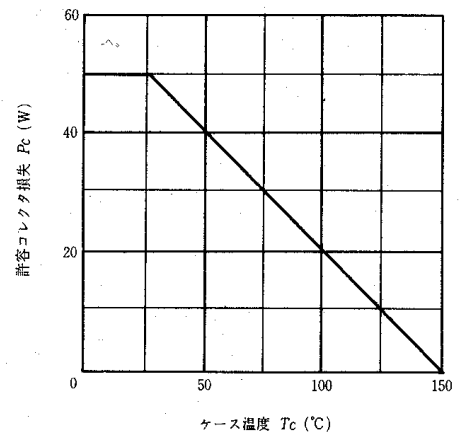
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 項目 | Symbol | 2SC3342 | Unit |
|-------------|----------------------|----------|------------------|
| コレクタ・ベース電圧 | V_{CBO} | 1300 | V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V_{CEO} | 500 | V |
| エミッタ・ベース電圧 | V_{EBO} | 6 | V |
| コレクタ電流 | I_C | 5 | A |
| せん頭コレクタ電流 | $i_{C(\text{peak})}$ | 6 | A |
| 許容コレクタ損失 | P_C^* | 50 | W |
| 接合部温度 | T_j | 150 | $^\circ\text{C}$ |
| 保存温度 | T_{stg} | -45~+150 | $^\circ\text{C}$ |

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

| 項目 | Symbol | Test Condition | min. | typ. | max. | Unit |
|---------------|----------------------|---|------|------|------|---------------|
| コレクタ・エミッタ破壊電圧 | $V_{(BR)CEO}$ | $I_C=10\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$ | 500 | — | — | V |
| エミッタ・ベース破壊電圧 | $V_{(BR)EBO}$ | $I_E=10\text{mA}$, $I_C=0$ | 6 | — | — | V |
| コレクタ遮断電流 | I_{CES} | $V_{CE}=1,200\text{V}$, $R_{BE}=0$ | — | — | 0.5 | mA |
| コレクタ・エミッタ飽和電圧 | $V_{CE(\text{sat})}$ | $I_C=3\text{A}$, $I_B=0.6\text{A}^*$ | — | — | 5 | V |
| ベース・エミッタ飽和電圧 | $V_{BE(\text{sat})}$ | $I_C=3\text{A}$, $I_B=0.6\text{A}^*$ | — | — | 1.5 | V |
| 蓄積時間 | t_{stg} | $I_{cp}=3\text{A}$, $I_{B1}=0.6\text{A}$ | — | 3 | — | μs |
| 下降時間 | t_f | $I_{cp}=3\text{A}$, $I_{B1}=0.6\text{A}$ | — | 0.2 | — | μs |

*パルス測定

* Pulse Test